MANUFACTURE OF PRECISELY POLISHED GLASS

Patent Number:

JP1040267

Publication date:

1989-02-10

Inventor(s):

SHIBANO YUKIO; others: 02

Applicant(s):

SHIN ETSU CHEM CO LTD; others: 01

Requested Patent:

JP1040267

Application Number: JP19870197781 19870807

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain a photomask glass substrate having a high resolution without surface scattered light in a short time by finishing a roughly polished glass surface by using colloidal silica.

CONSTITUTION:A surface of glass such as quartz glass is polished by using an abrasive primarily composed of cerium oxide having a large polishing speed,. Then, the polished glass surface is finished by using colloidal silica to remove in a relatively short time a work-affected layer generated on the glass surface polished by the abrasive primarily composed of cerium oxide.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-40267

@Int_Cl_4

識別記号 庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月10日

B 24 B 37/00

F-7712-3C H-7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

国発明の名称 精密研摩ガラスの製造方法

> ②特 頤 昭62-197781

❷出 願 昭62(1987)8月7日

砂発 明 者 柴 野 新潟県中領城郡領城村大字西福島28番地の1 信越化学工 由起夫 菜株式会社合成技術研究所内

四発 明 者 長 谷 Ш 均 新潟県中頸城郡頭城村大字西福島28番地の1 信越化学工 菜株式会社合成技術研究所内

ぴ発 明 老 山智 公 司 新潟県中頭城郡大潟町大字渋柿浜字五ケ割935-1 直江 津精密加工株式会社内

信越化学工業株式会社 ⑪出 願 人 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

包出 顖 直江津精密加工株式会 人 新潟県中頭城郡大潟町大字渋柿浜字五ケ割935-1

砂代 理 人 弁理士 山本 亮一 外1名

> 明 細

1. 発明の名称

精密研摩ガラスの製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. ガラス表面を酸化セリウムを主材とする研摩 材を用いて研摩したのち、コロイダルシリカを 用いて仕上げ研摩することを特徴とする精密研 摩ガラスの製造方法。
- 2. コロイダルシリカが比表面積200~600 m²/gのものである特許請求の範囲第1項記載の 精密研摩ガラスの製造方法。
- 3. コロイダルシリカが粒径300nm 以下のもの である特許請求の範囲第1項記載の精密研摩ガ ラスの製造方法。
- 4. コロイダルシリカがアルコキシシランをアン モニア性アルカリ触媒を含有する水ーアルコー ル中での加水分解で作られたものである特許請 求の範囲第1項記載の精密研摩ガラスの製造方 i‡.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は精密研摩ガラスの製造方法、特には短 時間で表面粗さ、最大高さが20点以下でマイク ロスクラッチ、加工変質層、潜傷の存在しない無 **擾乱な面をもつ精密研摩されたガラスを製造する** ことができるので、光照射したときの表面散乱光 を大巾に減少させることのできるフォトマスク、 ミラー、レンズ用などの光学用ガラスの製造に有 用とされる精密研摩ガラスの製造方法に関するも のである。

(従来の技術)

ガラス表面の鏡面研摩はラッピング後の加工物 を水あるいは油に分散させた研摩材を介して工具 (ポリッシャー) にこすりつける研摩方法で行な われており、このポリツシヤーとしては軟質のピ ッチポリッシャー、基布の上にウレタン樹脂を含 投させた不織布が使用され、研摩材としては粒子 径が1 μm 前後の酸化セリウム、酸化ジルコニウ ム、酸化アルミニウムを主材とするものが使用さ

れている。

しかし、これらの研摩材とポリッシャーとの組合せで、アルミナ、炭化けい素、ダイヤモンドなどの遊越砥粒と加工液としての水を介して加工物と工具のラップ・プレートをすり合わせるラッ短により得られる面を研摩すると、比較の表では近面とすることができるけれた状態となるため面組されて関連による無数の次小な引っかき傷くかではいるのとなるし、これはまた表面を担かでなります。これはまた表面を担かで発力のとなるし、これはまた表面をしているとなるとはでガラス表面を加工をないた発生する大路(潜傷)がなくとができないた発生ない無優乱な面とすることができないとので利がある。

また、シリコンなどのような半導体単結晶をコロイダルシリカを使用して研摩して無擾乱な面を得ることはよく知られれいるところである(特公昭49-13665号公報参照)が、コロイダルシリカを用いた研摩速度は酸化セリウムを使用した場合の

本発明の方法において始発材とされるガラスは 石英ガラス、低膨張ガラス、白板ガラス、BK-7などのようにSiO』を主成分とするものとす ればよい。

本発明の方法はこのガラス表面を酸化セリウム

1/20~1/80と非常に遅いためにガラス面のラッピングによる加工変質層をコロイダルシリカ研磨のみで除去するには 1 0~2 0時間が必要とされるので経済的ではないという問題点がある。

なお、ガラス表面の研摩については半導体素子の高集積化が進むにつれてフォトマスクにもバターン線巾の細密化、解像力の向上という高精度の微細加工技術が要求され、このフォトマスク用ガラス基板についてはフォトリソグラフに使用される光の波長が短かくなるにつれてその表面粗さに起因する表面散乱光の増加、解像力の低下を防止することも求められており、この対策が検討されている。

(発明の構成)

本発明はこのような不利を解決した精密研察されたガラスの製造方法に関するものであり、これはガラス表面を酸化セリウムを主成材とする研摩材を用いて研摩したのち、コロイダルシリカを用いて仕上げ研摩することを特徴とするものである。

を主材とする研磨材を用いる研磨とコロイダルシ リカを使用する仕上げ研摩の二段処理とするもの であるが、この第1工程において使用される研歴 材はこの酸化セリウムが平均粒径0.3 μα以下の ものでは研摩速度が小さく、平均粒径が 3 μ m 以 上のものとすると研摩速度は早くなるが加工変質 層が深く残るので平均粒径が0.3 ~3μm の範囲 のものとすることがよく、ここに使用するポリッ シャーについては基布としての不磁布にポリゥレ タン樹脂を含浸、発泡させたもの、基布の上にポ リウレタン発泡層を設け、直径が50μπ程度で 深さが約200μmの小さな壺状の閉じた穴を多 数有する構造としたスウエートタイプの研摩布ま たは松ヤニを用いたピッチポリッシャーとすれば よい。なお、この研摩材、ポリッシャーを用いた 研摩加工は一般に使用する片面あるいは両面研摩 用の装置あるいは枝葉式研摩装置を用いて0.01~ 5 Kg/cm²、好ましくは0.02~1 Kg/cm²の加工圧力 で行なわせればよく、この研摩液は前記酸化セリ ウムを水に5~30重量%の濃度で懸濁させたも

のとすればよい。この研摩は上記加工装置の回転 定盤にポリッシヤを取り付けガラス試料をその加 工装置の定められた場所に取り付け、研摩液とし て調整された酸化セリウムスラリーを研摩面に供 給しながら研摩を行なえばよい。

また、この第2工程としてのコロイダルシリカによる研摩は、市販されている粒径が10~150mmの無定形シリカ粒子を水に均一に分散に濁液を使用すればよいが、このシリカ濃度は50m畳がりませばよいが、たのシリカ濃度は50m畳が、10円ではシリカが乾燥して塊となり易く、し質がいるとがラスを重量が、10円では投入の範囲の形成がむずかは20~40m畳がの範囲のものとすることがよい範囲に、10円ので、10円の無機でルカリカので、NaOH、KOH等の無機でルカリカ

 $\sim 600 \, m^2/g$ の範囲のもの、好ましくは $300 \, \sim 450 \, m^2/g$ のものとすることがよい。

また、この細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは製造条件を選ぶことで10~1000 nmの粒径を持たせることが可能であるが、無擾乱のガラス表面を得るためには粒径が300 nm以下、好ましくは150 nm以下のものとすることがよい。

なお・フの細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは特願昭61-221569による方法で得られるものであり、これは滴下ロート、温度計、メタノール、アンモニア水を入れ、密閉下に加温メタール、アンモニテトラメトキシランとはカールながらここにテトラメトキシシカにとなったの混合液を滴によってアンモニア、メタノールの混合液を滴によってアンモニア、メタノールの混合液を滴によってアンモニア、メタノールの混合液を滴によってアンサールをないまたである。さらに前述の如く、このものはまたアルカリトとするがラスのエッチング効果を上げるためによるガラスのエッチング効果を上げるためによるガラスのエッチング効果を上げるためによるガラスのエッチング効果を上げるためによるガラスのエッチング効果を上げるためによるガラスのエッチング効果を上げるためによるガラスのエッチング効果を上げるのとする

アミン等の有极アルカリを新たに添加し、 p H を 高めて使用する方がアルカリのガラスをエッチン グする効果も相利的に発揮されるので好ましい。

また、市販のコロイダルシリカの比表面積は 20~100 a²/8と表面が滑らかな球の各々の粒 径に応じた値を持っているが、表面に微細な細孔 を有するか、または内部が多孔質である球状のコ ロイダルシリカを用いれば仕上げ面品位が更に向 上することを本発明者らはつきとめた。

上記の恕孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは例えば特願昭 61-2215 69 の方法により得られ、それに依ればこの細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは内部細孔の表面も比表面積値に含まれる事から200~600m²/8という極めて大きな値を持ち、その表面活性故に均質度の高い仕上げ研摩面が得られる。この比表面積については200m²/8以下では粒子表面はかたく、仕上り面は粗くなり研摩上よくなく、600m²/8以上とすると粒子表面が非常にもろくなり、短時間で加工能力が低下するので好ましくないので、20

とがよいので、このシリカ懸濁液にNaOH、 KOHなどの無機系アルカリ、アミンなどの有機 アルカリを少量添加したものとすることがよい。

このコロイダルシリカによる研摩工程に使用されるポリッシャーとしては不織布やスウエードタイプ研摩布等が用いられるが、スウエードタイプ研摩布が好ましい。また研摩装置は第1工程における酸化セリウムによる研摩工程と同じく、で使用されている片面あるいは両面研摩装置と一般に使用されている片面あるいは両面研摩装置として、ない。この方はは酸化セリウム研摩とはない。この方法は酸化セリウム研摩と同様な方法で加工装置の回転定盤にポリッシャを取り付け、がラス試料をその加工装置の定められた場所に取り付け、研摩液としてコロイダルシリカを供給しながら研摩を行なえばよい。

本発明の方法はラップ仕上げされたガラス表面を上記した酸化セリウムを主材とする研摩材を用いて研摩する第1工程と、ついでこの第1工程で 処理されたガラス面をコロイダルシリカを用いて 仕上げ研摩する第2工程とからなるものであるが、これによれば30~90分間という短時間の処理で表面粗さが最大高さR nax で20A以下でマイクロスクラッチ、加工変質層、潜傷が存在しない無優乱な面をもつガラスを容易に得ることができるので、光照射による表面散乱光を大巾に減少させ、性能を著しく向上させた光学系のフォトマスク、ミラー、レンズなどに有用とされるガラスを有利に製造することができる。

つぎに本発明の実施例をあげるが、例中におけるガラス表面の物性測定は下記の方法による測定 結果を示したものである。

[表面の粗さ]

表面の粗さ測定器・タリステップ (ランクテーラーホブリン社製商品名) を用いてスタイラス0.5 μm 、針圧 2 mgで測定した。

[マイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層]

ガラス表面に光ビームを照射し、その散乱光を 目視で観察すると共に、ノマルスキー微分干渉顕 微鏡・オブティホト(ニコン社製商品名)で観察

で、マイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層のない無擾乱の石英ガラス板が得られた。

しかし、比較のために上記における研摩を酸化セリウム砥粒を用いる研摩だけとしてこれを30分間行なったところ、この場合に得られた石英ガラス板は表面粗さ(Rasz)が50Aでマイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層を有する擾乱をもつものであった。

夷施例2. 比較例2

比表面積が300m²/8. 平均粒径50nmの多孔 質球状コロイダルシリカを特願昭61-221569 にし たがって次の様にして調整した。

①水3.63 2、 メタノール11.82 2 及び28 重量 分 アンモニア水1.07 2 を滴下ロート、温度計、ターピン提择 図のついたガラス製フラスコに入れて密閉系とし、ウォターバス温度を調整し、授拌しながら3 7 でに保ち、②滴下ロートよりテトラメトキシシラン1.52 Kgとメタノール2 2 との混合液をフラスコ内の温度を37±0.2 でに保ち、激しく提拌しながら30分にわたり滴下する。③このシリカ

した.

なお、 潜傷についてはこれを顕在化させるため に 1 0 重量%のフッ酸水溶液でガラス表面の溶解 を行なった。

夷施例1、比較例1

両面研摩機の回転定盤上にスウェートタイプ研摩布を接着剤で張りつけたのち、これにラッピングした長さ127 mm、巾127 mm、厚さ2.3 mm の高純度石英ガラスを取りつけ、研摩定盤を回転させてここに平均粒径が1~2μm である酸化セリウム砥粒を水で10重量%の濃度で懸濁させたスラリーを試料1枚当り0.5 2/分で供給しながら200g/cm²の研摩荷重で30分間研摩させたところ、ガラス表面が30μm 研摩された。

つぎにこの研摩材を比表面積が60m²/gで平均粒径が50mmのシリカを40重量%含有するコロイダルシリカ(不二見研摩材工業社製)として、これを試料1枚当り0.5 2/分で供給し、研摩荷重80g/cm² で30分間研摩してガラス表面を1m研摩したところ、表面粗さ(Rmx)が20Å

ゾル液を100Torrで、最終液温度が51セになるまで減圧蒸留してアンモニア、メタノールを除去する。

実施例1において使用したコロイダルシリカをこのコロイダルシリカとしたほかは実施例1と同様に処理したところ、合計時間60分で表面粗さ(Roax)が10Aでマイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層のない無優乱の石英ガラス板を得られた。

しかし、比較のため実施例1における酸化セリウム砥粒による研摩を行なわず、上記したコロイダルシリカによる研摩だけとして石英ガラスを30μm研摩したところ、表面粗さ(Rmax)が10Aでマイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層のない無擾乱の石英ガラス板を得ることができたが、この場合には15時間の研摩が必要であった。

特開昭64-40267(5)

事 稅 初 正 湿

昭和62年 9月18日

特許庁長官 小川邦 失 股

1. 事件の表示



昭和62年特許城第197781号

2. 発明の名称

精密研修ガラスの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称名称

(206) 倡越化学工菜株式会社 直汇准符宏加工株式会社

4. 代理人

住所 〒103東京都中央区日本橋本町4丁目4番11号 永井ビル [電話 東京 (270) 0858 1 氏名 弁理士 (6282) 山 本 名 一切計 切割に

住所 〒103東京都中央区日本橋本町4丁目4番11号 永井ビル[電話 東京 (270) 0858] 氏名 弁理士 (9373) 荒 井 緑 町分野

5. 補正命令の日付

「自 発」

6. 補正の対象

明細帯および図面

7. 補正の内容

(前出) で撮影した画像を第3図に示した。

4. 図面の簡単な説明

図は実施例、比較例で得られたガラスの扱面状態をノマルスキー做分干渉顕微鏡で撮影した画像を示したもので、第1図は実施例1、第2図は比較例1、第3図は実施例2で得られたガラスの扱面状態の画像を示したものである。」

6. 「第1図、第2図、第3図」を別紙のとおりに提出する。

以上

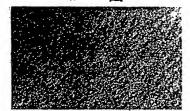
- 1. 明細杏郎 4 頁 8 行~ 9 行の「フォトマスク用ガラス拡板」を「フォトマスク」と補正する。
- 3.明細音第12頁19行~20行の『1nm研磨』を 『1点研摩』と補正する。
- 4. 明初書第13頁6行の「50A」を「50A」と 補正し、同頁8行の「ものであった。」のあとに 下記の文章を挿入する。

「なお、上記した実施例1、比較例1で初られた ガラスの表面状態をノマルスキー效分干渉凱徴館・ オプテイホト (前出) で撮影した画像を第1回、 第2回に示した。」

5. 明細登第14頁7行および14行の「10A」を 「10A」と相正し、同頁最下行の「必要であった。」のあとに下記の文章を挿入する。

「なお、この実施例2で得られたガラスの表面状態をノマルスキー微分干渉顕嫩鏡・オプティホト





第 2 図



第 3 図

